

1.产品特征

- •基于感应原理的位置感应
- •工作电压:3.5 V至18v
- •工作温度:-40°C至150°C
- •气隙高达1.5 mm
- •电流线接口(2线)或漏极输出(3线)
- •逆变电压保护、欠压闭锁保护、热保护
- •集成自诊断功能,激活专用安全模式
- •EMI抗干扰性能优
- •MSL 3

2.应用

安全带扣

座椅定位

门锁和把手

车载充电挡板

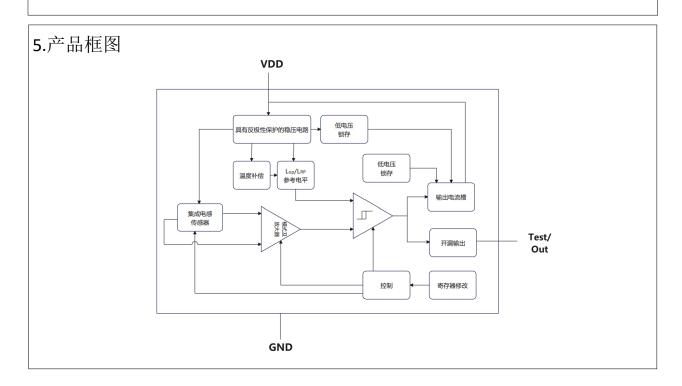
刹车灯开关





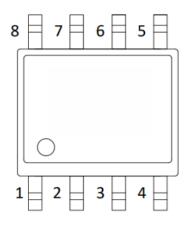
4.产品描述

TVHSCMM45是传周半导体退出的一款电感式开关芯片,采用混合信号亚微米CMOS技术设计,通过将线圈和接口完全集成在芯片内进行创新,使工程师无需为其应用开发笨重的 PCB 和线圈解决方案,用于检测导电目标的存在,该芯片内部集成了一个3.5V到18V的LDO,采用电流型2线输出接口或者看漏3线输出接口,2线接口不仅节省了一根导线,还可以实现反极性连接和故障检测等诊断功能。芯片内部如果结温超过异常高的阈值,芯片上的热保护功能会关闭输出,一旦温度降至安全值以下,芯片将自动恢复。





6.管脚图



TOP View

7.管脚信息

序号	名称	类型	功能
1	OUT	输出	开漏输出
2	GND	地	地引脚
3	VDD	供电	供电电压引脚
4-8	/	N. C.	无连接

8.绝对最大额定功率

参数	特征值	数值	单位
供电电压	$V_{ ext{DD}}$	28	V
供电电压(负载转储)	$V_{ ext{DD}}$	32	V
供电电流(1,2,3)	${ m I}_{ m DD}$	20	mA
反向供电电压(1,2)	$ m V_{ODREV}$	-24	V
反向供电电流(1,2,5)	${ m I}_{ m DDREV}$	-20	mA
输出电压	$ m V_{out}$	5	V
输出电流	${ m I}_{ ext{out}}$	5	mA
反向输出电压	$ m V_{outrev}$	-0.5	V
反向输出电流	${ m I}_{ m OUTREV}$	-5	mA
最大节温	Tj	165	${\mathbb C}$
ESD-HBM(VDD pin)	_	8	KV
ESD-CDM	_	1000	V
ESD-HBM(OUT pin)	=	500	V

备注:超过绝对最大额定值可能造成永久损坏。暴露在绝对最大额定值长时间的运行会影响设备的可靠性



9.电气特性

直流工作参数VDD = 3.5V $^{\sim}$ 18V, TJ = -40° C $^{\sim}$ 125° C

参数	特征	测试条件	Min	Тур	Max	Units
子	т		2	-	5	mA
关断电源电流	${ m I}_{ m OFF}$		5	_	6.9	mA
供电电流	$\mathrm{I}_{\scriptscriptstyle{\mathrm{ON}}}$		12	_	17	mA
反向电源电流	$I_{\text{\tiny DDREV}}$	VDD=-16V	-1	_	-	mA
安全供电电流	$I_{\scriptscriptstyle SAFE}$		0.8	_	1.4	mA
供给电流上升/下降时间	tR/tr	VDD=12V,CLOAD=50pF to GND	0.1	0.3	1	uS
拉通中海的中间	т	VDD=5V, dVDD/dt>2V/us,		40	70	uS
接通电源的时间	T_{on}	激活输出				
延迟时间	$T_{\scriptscriptstyle D}$		_	8	16	uS
抖动(pk-pk)	Тj				13	uS
开关频率	$F_{\text{\tiny SW}}$				20	kHz
低电压锁定阈值	$V_{\scriptscriptstyle UVL}$	With respect to VDD	2. 5	_	3.4	V
输出漏电流	${ m I}_{ m OFF1}$	During operation VOUT=3.6V			1	μA
导通输出电阻	R _{OUTON}			15	30	Ω
out引脚上拉电压	$V_{\scriptscriptstyle PU}$				3.6	V
集成旁路电容	C_{BP}		_	68	I	nF
热保护启动温度	T_{PROT}		_	190	-	$^{\circ}$
热保护释放温度	$T_{\text{\tiny REL}}$		_	180	-	${\mathbb C}$
上电时的默认输出状态	=	直接开关或锁存器		OFF		

10.应用参数

直流工作参数VDD = 3.5V $^{\sim}$ 18V, TJ = -40° C $^{\sim}$ 125° C

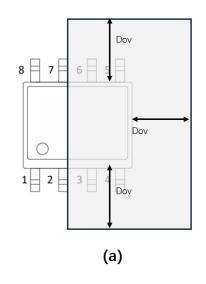
参数	特征	测试条件	Min	Тур	Max	Units
气隙探测距离锁存器	$A_{ extsf{DRL}}$	σTARGET=2. 32x10 ⁶ S/m			1.2	mm
气隙探测距离开关	$A_{ m DRS}$	σTARGET=2. 32x10 ⁶ S/m			1	mm
		A _{DRL} =1.2 mm	-0.3	0	0.3	mm
目标定位公差-锁存器		A _{DRL} =1 mm	-0.5	0	0.5	mm
		A _{DRL} =0.75 mm	-0.6	0	0.6	mm
		A _{DRS} =1mm	-0.3	0	0.3	mm
目标定位公差开关		$A_{DRS}=0.75$ mm	-0.5	0	0.5	mm
		A _{DRS} =0.5 mm	-0.6	0	0.6	mm



参数	特征	测试条件	Min	Тур	Max	Units
标靶厚度	dTARGET		0.1			mm
标靶电导率	σTARGET	DIN 1614(St24)	2. 32x106			S/m
断路器分离	Dsc	如图4和图5所示	0.81	0.88	0.95	mm
★☆ 11 +17 ML \+ +▽		"0"->Direct Output		1	-	bit
输出极性选择		"1"->Inverted Output	_			
按钮式功能选择		"0"-Disable push button mode"1"-	_	1	-	bit
		>Enable push button mode				
DD编程锁 — — — — — — —		"0"->EEPROM unlocked "1"->EE PROM Locked	_	1	_	bit
断开电流选择		"0"->2mAto5m A	_	1	_	bit
四月 电机起件		"1"->5mAto6.9mA		1		
Cust ID			_	8	_	bit

11.标靶位置

TVHEPPC00X既可以作为开关也可以作为锁存器。在开关操作模式下,只有芯片的一侧需要被目标覆盖,当移除目标时(或者目标覆盖)整个包至少有2mm重叠在每一边)状态是OFF。闩锁操作-左和右侧被交替覆盖,以实现开和关状态。开关的插图锁存器目标配置如图1所示。



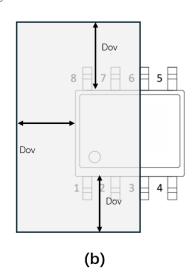


图 (1)

图1 SOIC8 封装上的目标位置,右开关(a)和左开关(b)的应用,说明了IC封装上的正确目标位置为ON状态(直接输出)。或者,对于锁存器编程(a)是打开状态,而(b)是关闭状态



11.动作模式-闩锁

当芯片被配置为闩锁模式时,需要目标覆盖包的一部分为打开状态,覆盖包的另一部分为关闭状态,如图2所示

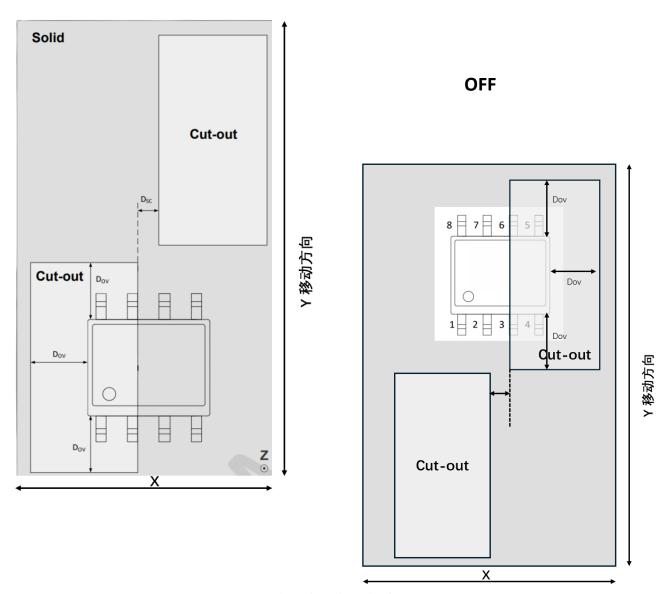


图2 SOIC8封装锁存操作,直接输出

12.动作模式-开关模式

当芯片被配置为闩锁模式时,需要目标覆盖包的一部分为打开状态,覆盖包的另一部分为关闭状态,如图3所示

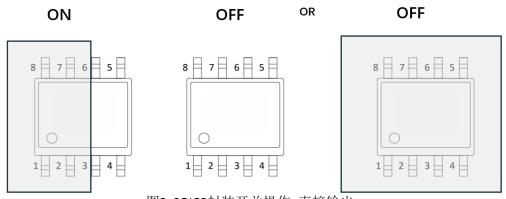
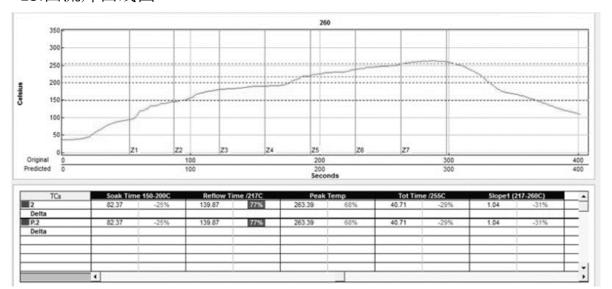


图3 SOIC8封装开关操作,直接输出

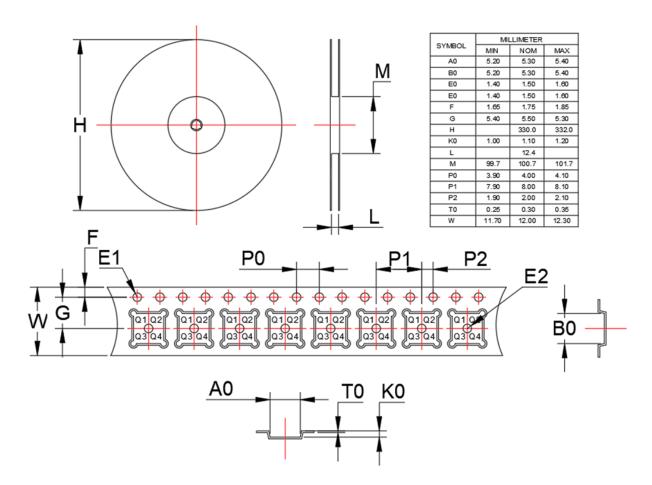


13.回流焊曲线图



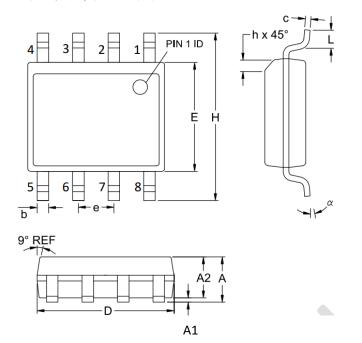
14.包装尺寸图

型号	封装	Pin脚数量	封装数量	环保标识	Pin1 象限
TVHEPPC00X	SOC	8	2500	RoHS	Q2





15. 封装尺寸图(单位: mm)



特性	MINIMUM	MAXIMUM	
A	1.52	1.73	
A1	0.1	0.25	
A2	1. 37	1.57	
D	4.8	4. 98	
Е	3.81	3.99	
Н	5.8	6. 2	
L	0.41	1.27	
b	0.35	0.49	
С	0. 19	0.25	
h	0. 25	0.5	
е	1. 27B SC		
a	0°	8°	

16. 版本信息

版本	时间	章节	修改	页面
C1	2024.10.13	新规	新规	新规